

3DU₁₁₋₃₃ 型硅光电三极管

一．特性与用途

用于近红外光探测、光耦合、编码器、译码器、特性识别、过程控制、激光接收等方面，具有灵敏度高、光电流大等特点。

二．结构

金属-玻璃全密封封装，玻璃透镜窗口。

三．使用条件

贮存温度 -55~+175 环境温度：-55 ~+125

四．执行总规范

军品：GJB33A-97 《半导体分立器件总规范》

QZJ840611 《半导体二、三极管 "七专" 技术条件》

QZJ840611A 《半导体分立器件 "七专" 技术条件》

LMS214-99 《半导体光电器件 "七专" 加严技术条件》

民品：GB4589.1-89 《半导体器件分立器件和集成电路总规范》

五．执行标准

军品：Q/QHLJ10-99 Q/QHLJ20009-2000

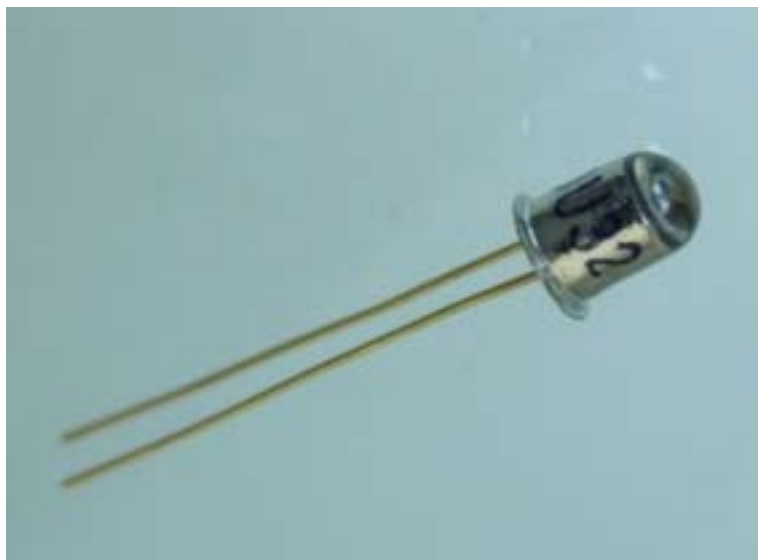
民品：Q/QHL02A-2001

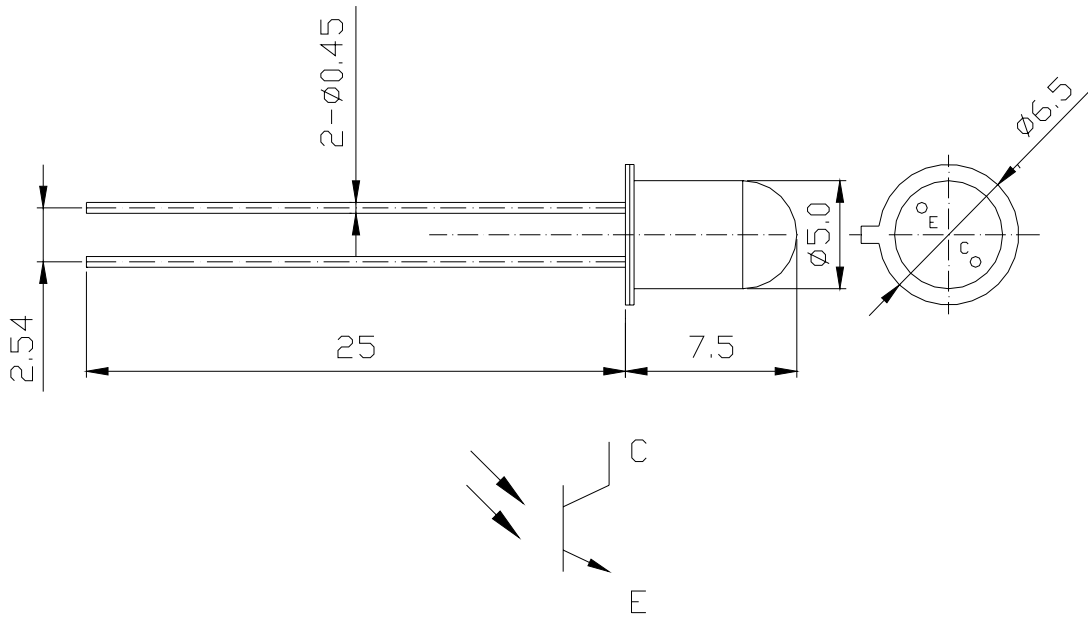
六．质量等级

军品：J、G、G+、JP、JT、JCT

民品：类

七．外形及逻辑图(外形尺寸仅供参考)





八. 参数表

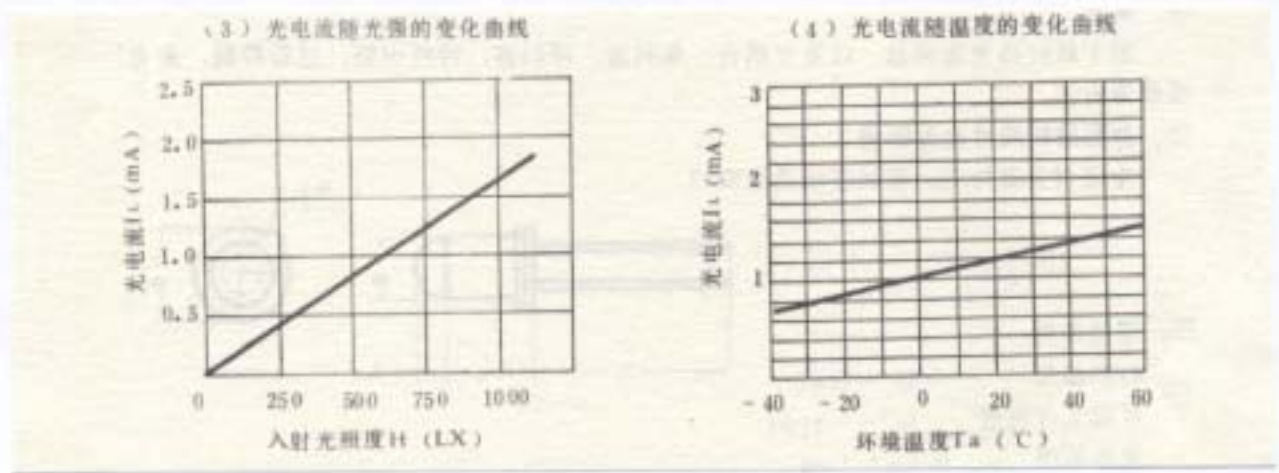
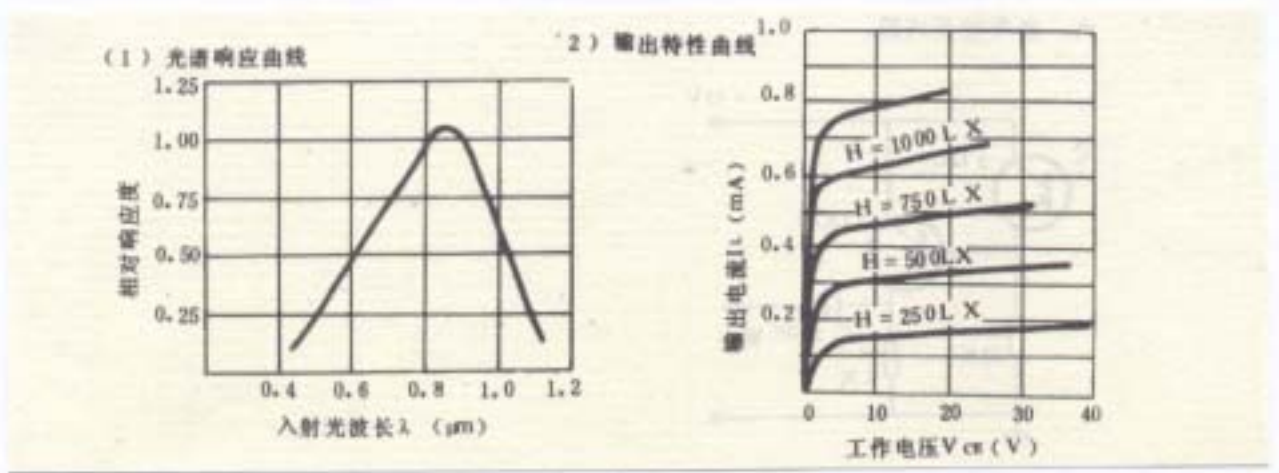
(Ta=25)

参数 型号	最高 工作电压	暗电流	光电流	响应时间		光谱 范围	峰值 波长	最大 功耗	质量 等级
	$V_{(RM)CE}$ (V)	I_D (μA)	I_L (mA)	t_r (μs)	t_f (μs)	(nm)	λ_p (nm)	P_M (mw)	
3DU ₁₁	10	0.15	0.5-1.0	10	10	400-1100	880	100	民品
3DU ₁₂	30								民品
3DU ₁₃	50								民品
3DU ₂₁	10		1.0-2.0	3	4				民品
3DU ₂₂	30								民品
3DU ₂₃	50								民品
3DU ₃₁	10		2.0	10	10				民品
3DU ₃₂	30								军品
3DU ₃₃	50								民品
测试 条件	$I_{CE} = I_D$	无光照 $V_{ce}=30V$	$V_{CE}=10V$ $H=1000LX$ $T=2856^0K$	$V_{CE}=10V$ $R_L=50$					
试验类 别	JS	JS	JS	C		C	C	C	

九. 特性曲线 (仅供参考)

(见附图十)

附图十



[返回主页](#)

[返回上一级](#)